

第4回

WORKSHOP

EUV-FEL

2019 12.10 火 13:00-17:05

開場 12:30

プログラム

2019 年 12 月 10 日

12:30 受付開始

13:00 開会挨拶

EUV-FEL 光源産業化研究会 代表 石原 直 (東京大学)

13:10 - 13:50

基調講演

座長: 河田 洋 (KEK)

「産業界への波及を目指す新波長域レーザー技術開発」

"R&D on new lasers with unexplored wavelengths aiming at industrial application"

佐藤 正健 (産業技術総合研究所)

Tadatake Sato (AIST)

13:50 - 14:30

基調講演

座長: 鈴木 章義 (AS リソグラフィコンサルティング)

「先端半導体とパターニング技術の現状と今後」

"Trend of Leading-Edge Semiconductors and the Patterning Technologies"

井上 壮一 (キオクシア株式会社)

Soichi Inoue (KIOXIA)

— コーヒーブレイク 【14:30 - 15:00】 —

15:00 - 17:00

一般講演

座長: 羽島 良一 (QST) / 木下 博雄 (兵庫県立大学)

15:00 - 15:30

「cERL を用いた高繰り返し FEL の実証と EUV-FEL のその先」

"Demonstration of high-repetition FEL using cERL and beyond EUV-FEL"

加藤 龍好 (高エネルギー加速器研究機構)

Ryukou Kato (KEK)

15:30 - 16:00

「レジスト材料の軟 X 線 FEL 光照射に関する研究」

"Study on the soft X-ray FEL light irradiation of resist materials"

岡本 一将 (大阪大学)

Kazumasa Okamoto (Osaka Univ.)

16:00 - 16:30

「リソグラフィ応用光源 (DUV/EUV) の最近の進展」

"Leading Edge Short Wavelength Light Source (DUV/EUV)
for High Volume Semiconductor Manufacturing"

溝口 計 (ギガフoton株式会社)

Hakaru Mizoguchi (GIGAPHOTON INC.)

16:30 - 17:00

「超伝導高周波加速器の低コスト化と次世代技術」

"Cost reduction of superconducting rf accelerator and next-generation technology"

道園 真一郎 (高エネルギー加速器研究機構)

Shinichiro Michizono (KEK)

17:00 閉会の辞

17:05 閉会